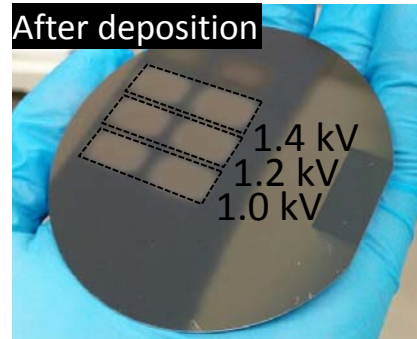
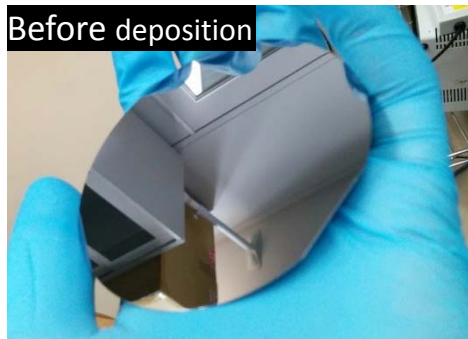


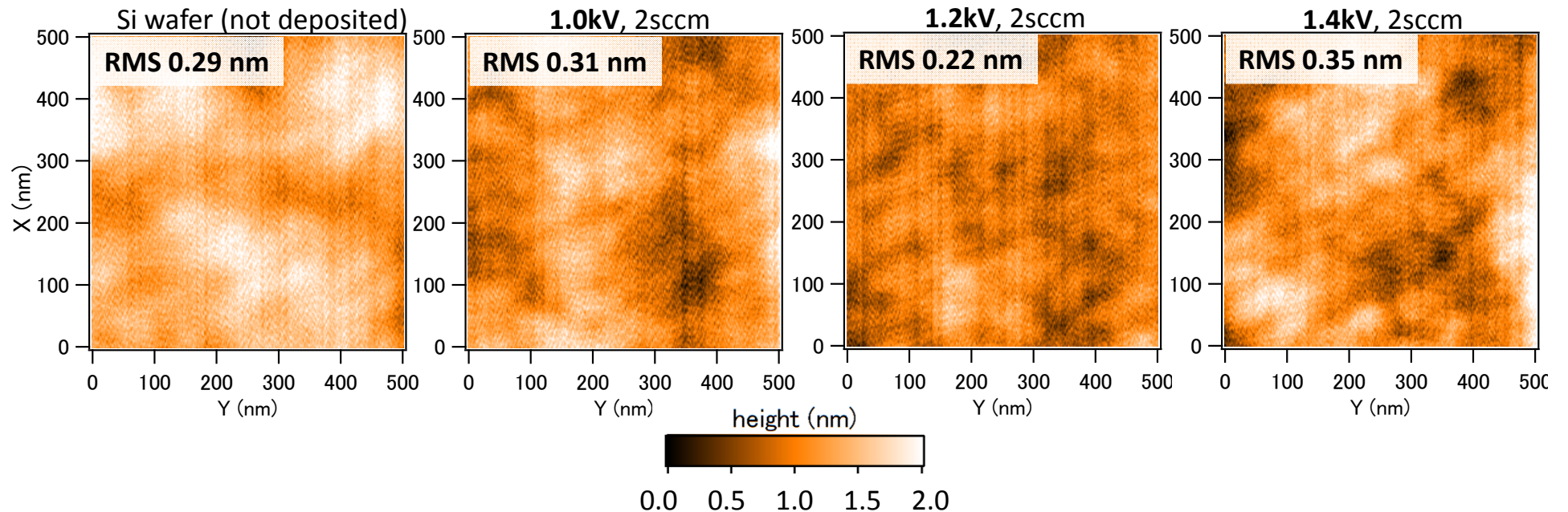
基本的な性能の調査(表面粗さ)

Si基板上にNiを成膜



Si基板上に直接Niを成膜
ガス流量→2 sccm
イオン加速電圧→1.0, 1.2, 1.4 kV

AFM計測結果



基盤の表面粗さを保ったまま成膜可能